
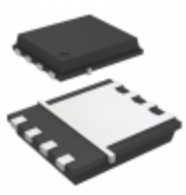
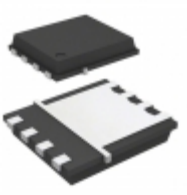


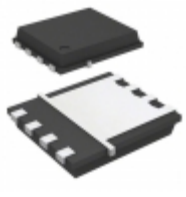



	<p>BSC018NE2LSIATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC018NE2LSIATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 29A TDFN-8</p> <p>Datenblätter:  BSC018NE2LSIATMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC018NE2LSIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 29A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC018NE2LSIATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 29A (Ta), 100A (Tc) 2.5W (Ta), 69W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	29A (Ta), 100A (Tc)

BSC018NE2LSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC018NE2LSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC018NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC018NE2LSIATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC018NE2LSI Infineon Technologies BSC018NE2LSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSC019N02KSGAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 100A TDFN-8</p>	 <p>BSC018NE2LS INFINEON BSC018NE2LS INFINEON</p>	 <p>BSC018NE2SXT INFINEON BSC018NE2SXT INFINEON</p>
 <p>BSC018NE2LSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 100A TDFN-8</p>	 <p>BSC019N02KS Original BSC019N02KS Original</p>	 <p>BSC018N04NS3G INFINEON INFINEON TDFN-8-4</p>	 <p>BSC019N02KS G INFINEON BSC019N02KS G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC018NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC018NE2LSIATMA1 Datenblatt	BSC018NE2LSIATMA1-Datenblätter	BSC018NE2LSIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC018NE2LSIATMA1
BSC018NE2LSIATMA1 Electronic	BSC018NE2LSIATMA1-Komponenten	BSC018NE2LSIATMA1-Verteiler	BSC018NE2LSIATMA1-Bild	BSC018NE2LSIATMA1-Teil
BSC018NE2LSIATMA1 Preis	BSC018NE2LSIATMA1 Hersteller	BSC018NE2LSIATMA1 Bild	BSC018NE2LSIATMA1 Aktie	BSC018NE2LSIATMA1 Inventar
BSC018NE2LSIATMA1 Neu	BSC018NE2LSIATMA1 Original	BSC018NE2LSIATMA1 garantiert	BSC018NE2LSIATMA1 RFQ	BSC018NE2LSIATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited